



Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного
применения

Полупроводниковый Элемент Низкочастотного Диода Тип DR32-1000-20

Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾					I_{FAV}		1000 А		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение					U_{RRM}		1000...2000 В		
U_{RRM} , В	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Класс по напряжению	10	11	12	13	14	15	16	18	20
T_j , °C	-60...+190								

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

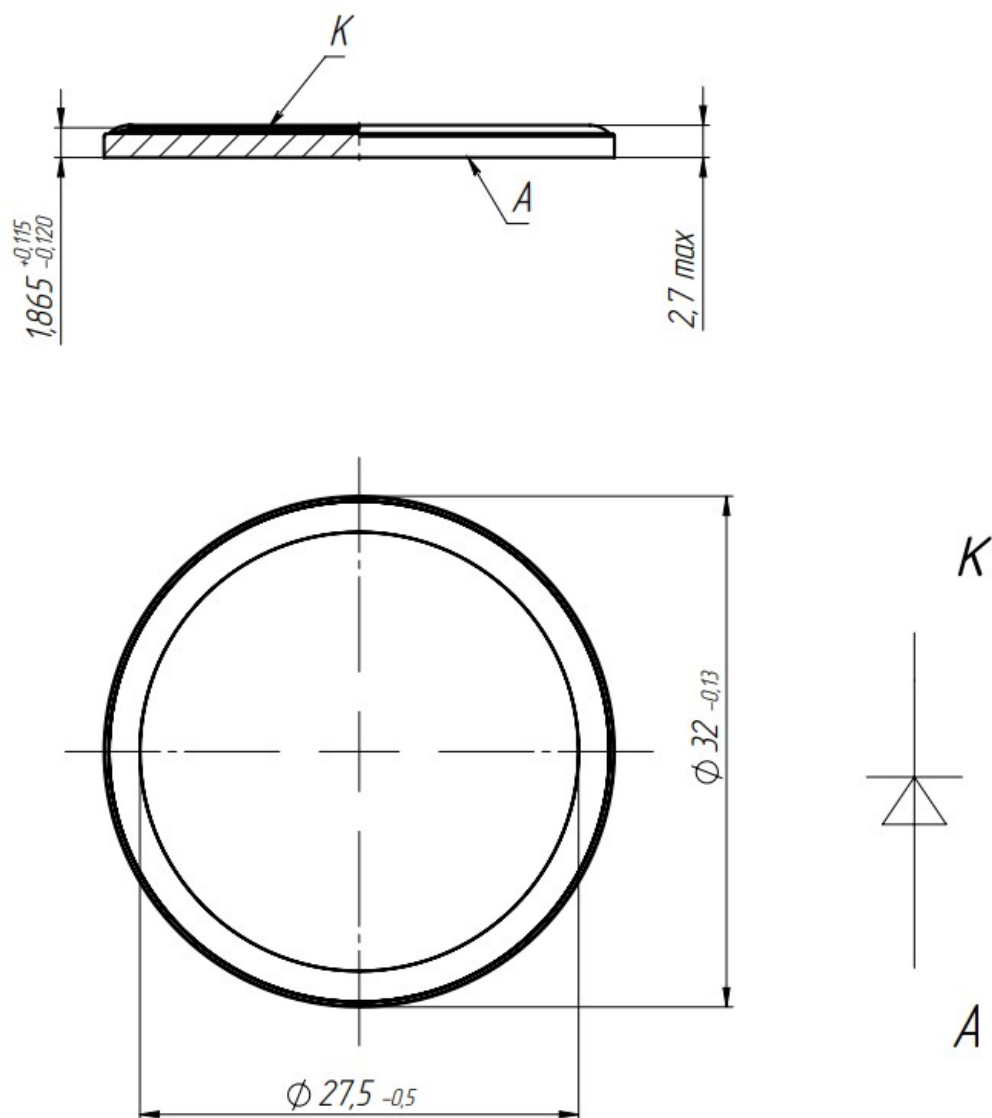
Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾	А	1000 1331	$T_c=131\text{ }^{\circ}\text{C}$; двухстороннее охлаждение; $T_c=100\text{ }^{\circ}\text{C}$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток ¹⁾	А	1570	$T_c=131\text{ }^{\circ}\text{C}$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток ¹⁾	кА	16.0 18.0	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=10\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$
			17.0 20.0	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$
I^2t	Защитный показатель ¹⁾	A^2c10^3	1200 1600	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=10\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$
			1100 1600	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3\text{ мс}$; единичный импульс; $U_R=0\text{ В}$
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1000...2000	$T_{j\text{ min}} < T_j < T_{j\text{ max}}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1100...2100	$T_{j\text{ min}} < T_j < T_{j\text{ max}}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	В	$0.6\cdot U_{RRM}$	$T_j=T_{j\text{ max}}$	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	$^{\circ}\text{C}$	-60...+50		
T_j	Температура р-п перехода	$^{\circ}\text{C}$	-60...+190		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие ¹⁾	кН	9.0...11.0		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U _{FM}	Импульсное прямое напряжение ¹⁾ , макс	В	1.60	T _j =25 °C; I _{FM} =3140 А	
U _{F(TO)}	Пороговое напряжение, макс	В	0.828	T _j =T _{j max} ; 0.5 π I _{FAV} < I _T < 1.5 π I _{FAV}	
r _T	Динамическое сопротивление ¹⁾ , макс	МОм	0.264		
Блокирующие характеристики					
I _{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	50	T _j =T _{j max} ; U _R =U _{RRM}	
Тепловые характеристики					
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус ¹⁾ , макс	°C/Вт	0.040	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R _{thjc-A}			0.088		Охлаждение со стороны анода
R _{thjc-K}			0.072		Охлаждение со стороны катода
Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	14.20		

МАРКИРОВКА		ПРИМЕЧАНИЕ
DR 32 1000 20 1 2 3 4 1. ППЭ Низкочастотного Диода 2. Максимальный диаметр, мм 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению		¹⁾ В зависимости от характеристик применяемого корпуса. Указанные значения актуальны при использовании корпуса Протон-Электротекс D.B2.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Все размеры в миллиметрах

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.